

「輸出貿易管理令の運用について」

輸出注意事項 62 第 11 号・62 貿易局第 322 号

最終改正 輸出注意事項 2024 第 14 号・20240701 貿易局第 4 号

令和 6 年 7 月 8 日・貿易経済安全保障局

(抜粋)

★ 1-1 の (7) の (イ) 輸出令別表第 1 の解釈

輸出令別表第 1 の解釈は、次の表に掲げるところにより行う。

なお、輸出令別表第 1 中、次の表の「輸出令別表第 1 の項」の欄に掲げる事項について、それぞれ「輸出令別表第 1 (これに基づく貨物等省令を含む) 中解釈を要する語」の欄に掲げる語は、「解釈」の欄に掲げるところにしたがって解釈するものとし、「解釈」の欄が左右の二欄にわかれているときは、当該「輸出令別表第 1 中解釈を要する語」欄に掲げる語は、それぞれ左欄に掲げるものを含み、右欄に掲げるものを除くものとして解釈するものとする。

輸出令別表第 1 の項	輸出令別表第 1 中解釈を要する語	解	釈
7	輸出令別表第 1 の 7 の項の経済産業省令で定める仕様のもの	貨物等省令第 6 条第一号イ、ロ若しくはヌ、同条第二号イからワ又は同条第三号から第十六号の二までに該当するものであって輸出令別表第 1 の 1 の項から 1 5 の項までの中欄のいずれかに掲げられた貨物に使用するように特別に設計したもの又はこれと同じ機能特性のものは、輸出令別表第 1 の当該貨物の規定に基づいて判定するものとする。	
		貨物等省令第 6 条第一号、第二号、第四号、第七号の二又は第八号の二から第八号の四までに該当する貨物には、ウエハー上におけるパターン形成からパッケージングまでの工程の全ての状態のものを含む。	貨物等省令第 6 条第一号イ、ロ若しくはヌ、同条第二号イからワ又は同条第三号から第十六号の二までに該当するものであって、他の貨物(輸出令別表第 1 の 1 の項から 1 5 の項までの中欄のいずれかに掲げられた貨物を除く。)に使用するように設計したものを除く。
	ハイブリッド集積回路	集積回路を組み合わせたもの又は集積回路と回路素子若しくは個別部品を組み合わせて、特定の機能を行うように相互に接続したものであって、カプセル封じをしていないデバイスを 1 以上含むもので、通常の集積回路の製造方法を用いて相互接続されているもので、一体として交換可能なもので、かつ、分解することが不可能なものをいう。	
	マルチチップ集積回路	同一基板上にモノリシック集積回路を複数搭載したものをいう。	
	膜形集積回路	厚膜又は薄膜の堆積によって、絶縁基板上に回路素子及び金属相互接続のアレイを形成したものをいう。	
	光集積回路	モノリシック集積回路又はハイブリッド集積回路であって、1 以上の受光素子若しくは発光素子として機能するように設計した部品又は光機能若しくは光と電気の相互変換の機能を果たすように設計した部品を含むものをいう。	
三次元集積回路	半導体ダイ又はアクティブデバイス層の集合体であって、デバイス層同士の相互接続を形成するためのインターポーザー(電気的な接		

	続を可能にするためのインターフェースをいう。) 、基板、ダイ又は層を完全に貫通するビアを有するものをいう。	
モノリシックマイクロ波集積回路	マイクロ波又はミリ波の周波数で作動するモノリシック集積回路をいう。	
記録	アナログデジタル変換した連続的なデータをメモリに保存することをいう。	
信号処理	外部からの情報を伝送する信号を処理することであって、高速フーリエ変換、ウォルシュ変換その他の領域間の変換、時間圧縮、フィルター処理、抽出、選択、相関、たたみ込みその他これらに類するアルゴリズムを用いることを言う。	
貨物等省令第6条第一号ハ、ホからチまで及びルからワまでの集積回路	輸出令別表第1の1の項から15の項までの中欄のいずれかに掲げられた貨物に使用するように特に設計したものであって、設計又はプログラムを変更することができないものは、輸出令別表第1の当該貨物の規定に基づいて判定するものとする。輸出令別表第1の1の項から15の項までの中欄のいずれかに掲げられた貨物であるか否かを判断できない場合は、貨物等省令第6条第一号ハ、ホからチまで及びルからワまでに基づいて判定するものとする。	
		他の貨物（輸出令別表第1の1の項から15の項までの中欄のいずれかに掲げられた貨物を除く。）に使用するように特に設計したものであって、設計又はプログラムを変更することができないものを除く。
マイクロプロセッサ	論理演算ユニットを内蔵したものであって、外部記憶からの汎用命令を実行することができるものをいう。	
	マイクロコンピュータを除き、デジタルシグナルプロセッサ、デジタルアレイプロセッサ、デジタルコプロセッサ及び複数のチップから構成されたものであって、一緒に動作することによりマイクロプロセッサ機能を与えるように設計したチップセットを含む。	
マイクロコンピュータ	論理演算ユニットを内蔵したものであって、内部記憶内のデータに関して内部記憶からの汎用命令を実行することができるものをいう。	
	内部記憶が外部記憶により増補されたものを含む。	
不揮発性メモリー	長期間にわたり電源を遮断した後もデータの保持が可能なメモリーをいう。	
フィールドプログラマブルロジックデバイス	プログラムが既書き込まれているものであって、変更が可能なもの又は書換え可能なものを含む。	

最大クロック周波数	回路内部の最大クロック周波数をいう。ただし、外部よりクロックを与える場合にあつては、内部の回路が対応し得る最大動作周波数をいう。
貨物等省令第6条第一号ホ(一)中のアナログデジタル変換用のもの	<p>貨物等省令第6条第一号ホ(一)中のアナログデジタル変換用のもの(以下、「ADC」という。)については、以下のとおりとする。</p> <p>イ nビットの分解能とは、2^nレベルに相当する量子化能力をいう。</p> <p>ロ ADCの分解能は、測定したアナログ入力を表すデジタルの出力ビット数に等しい。有効ビット数(ENOB)はADCの分解能を決定するに当たり、使用しない。</p> <p>ハ 複数のチャンネルを有するADCについては、そのサンプルレートは複数のチャンネルを集合させたものではなく、1つのチャンネルのうち最大のものをいう。</p> <p>ニ インターリーブ型ADC又はインターリーブ方式で動作するように設計した複数のチャンネルを有するADCのサンプルレートは、インターリーブに係る全てのチャンネルのサンプルレートを集合させた最大のレートをいう。</p>
サンプルレート	ADC(オーバーサンプリング型ADCを除く。)において1秒当たりのアナログ入力で測定される最大のサンプル数をいう。オーバーサンプリング型ADCにおいては、その出力ワードレートをサンプルレートという。サンプルレートは、サンプリングレート(メガサンプル毎秒又はギガサンプル毎秒で表示。)又は変換レート(ヘルツで表示。)ともいう。
調整された更新速度	通常の(非補間型)デジタルアナログ変換用の集積回路(以下、「DAC」という。)の場合、デジタル入力信号がアナログ出力信号に変換されるときに速度をいい、アナログ出力値はDACにより変わる。補間モードを経由しない(補間率が1倍)ことができるDACは、通常の(非補間型)DACとみなす。補間型DAC(オーバーサンプリング型DAC)の場合、DAC更新速度を最小の補間率で除して得られた値をいう。補間型DACに係る調整された更新速度は、入力データレート、入力デジタルワードレート、入力サンプルレート、最大総入力バスレート、DACクロック入力用最大DACクロックレートともいう。
貨物等省令第6条第一号ホ(二)中の信号	スプリアス・フリー・ダイナミック・レンジの測定において、アナログ出力信号の振幅が-3デシベルフルスケールを超えるとき、そのデジタル入力信号はフルスケールである。
スプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ	基本周波数の信号をDACに入力したときにデジタルアナログ変換されて出力される基本周波数(最大信号成分)の実効値の、基本周波数に次いで高い出力振幅である雑音又は高調波歪成分の実効値に対する比率をいう。直接、仕様書又はスプリアス・フリー・ダイナミック・レンジの周波数依存性に関する特性図により表される。
レーザー発振器	2の「レーザー発振器」の解釈に同じ。
最大デジタル入出力数	集積回路又はパッケージされているか否かに関わらず、使用者が使用できる最大の入出力数又は使用することができる最大の入出力数をいう。
シリアルトランシーバーの最大データ速度の	当該フィールドプログラマブルロジックデバイスにおける一方向へデータ転送するシリアルトランシーバーの最大データ速度にトランシーバー数を乗じて得られた値をいう。

総計	
基本ゲート伝搬遅延時間	モノリシック集積回路に使用される基本ゲートに対応する伝搬遅延時間の値。この値は、モノリシック集積回路の各ファミリー（注）に対しては、当該ファミリー内の代表的なゲート当たりの伝搬遅延時間又は当該ファミリー内の代表的な伝搬遅延時間のいずれかで評価される。 （注） ファミリーは、集積回路の個別の機能を除いた製造方法及び仕様として次のすべての項目が適用される集積回路からなる。 a. 共通のハード及びソフトのアーキテクチャー b. 共通の設計技術及び加工技術 c. 共通の基本性能
カスタム集積回路	製造者が特定の顧客からの仕様の提示に基づいて製造し、その顧客に供給するもの又は供給したものをいう（製造者が、輸出令別表第1の5から15までの項の中欄に掲げられた貨物であるか否かを判断できないものに限る。）。
デジタルアナログ変換クロック周波数	マスタークロック周波数又は入力クロック周波数ともいう。
貨物等省令第6条第一号ワ（一）中のアナログデジタル変換機能を有するもの	貨物等省令第6条第一号ワ（一）中のアナログデジタル変換機能を有するものについては、以下のとおりとする。 イ nビットの分解能とは、 2^n レベルに相当する量子化能力をいう。 ロ ADCの分解能は、測定したアナログ入力を表すADCのデジタル出力ビット数に等しい。有効ビット数（ENOB）はADCの分解能を決定するに当たり、使用しない。 ハ インターリーブ型でない複数のチャンネルを有するADCが含まれた集積回路については、そのサンプルレイトは複数のチャンネルを集合させたものではなく、1つのチャンネルのうち最大のものをいう。 ニ インターリーブ型ADC又はインターリーブ方式で動作するように設計した複数のチャンネルを有するADCが含まれた集積回路のサンプルレイトは、インターリーブに係る全てのチャンネルのサンプルレイトを集合させた最大のレイトをいう。
貨物等省令第6条第一号カに規定する相補型金属酸化膜半導体集積回路	極低温CMOS又はクライオCMOSともいう。
真空電子デバイス	真空回路における電磁波の伝搬又は無線周波数空洞共振器を使用した電子ビームの相互作用を基礎とした電子デバイスをいう。
国際電気通信連合が無線通信用に割り当てた周波数帯域	最新版の国際電気通信連合無線通信規則により1次業務及び2次業務用に割り当てた周波数帯域をいう。 付加分配及び代替分配に割り当てた周波数帯域を除く。

空洞結合形	遅波回路として、軸方向に隣接して配設した複数個の空洞を電磁氣的に結合したものをいう。	
	空洞結合形の変形を含む。	
ヘリックス形	遅波回路として、1以上のヘリックス形の高周波遅波回路を用いたらせん形のものをいう。	
	はしご形、インタデジタル形、リングアンドバー形及びこれらの変形を含む。	
瞬時帯域幅	他の動作パラメータを変えない状態で、出力が3デシベル未満の変化範囲にとどまる帯域幅をいう。	
宇宙用に設計した	地表から100キロメートルを超える高度で動作するよう設計若しくは製造されたこと又は試験に合格して適格とされたことをいう。特定の貨物が試験に合格したことにより宇宙用に設計したと判定されても、同じ生産工程又は一連の型式である他の貨物は、個々に試験されなければ宇宙用に設計したことになる。	
デュアルモード	真空電子デバイスのビーム電流がグリッドを使用することで意図的に連続モードとパルスモードとの間で切り換えることが可能なものであって、最大パルス出力が連続波出力よりも大きいものをいう。	
熱電子陰極	固体を加熱することで電子を放出させる陰極をいう。	
モノリシックマイクロ波集積回路増幅器	貨物等省令第6条第二号ハの(一)から(八)でそれぞれ定める周波数帯域において、2以上の周波数帯域にまたがって作動するものについては、これらのうちピーク飽和出力値の最も低いものを制限値とする。	
モノリシック集積回路	受動回路素子、能動回路素子又はこれらの組合せであって、次のイからハまでのすべてに該当するものをいう。 イ 半導体材料の小片であるチップの中又はこの上に拡散プロセス、注入プロセス又は堆積プロセスによって形成されたもの ロ 分解することが不可能なように結合されたもの ハ 一つの回路の機能を実行するもの	
ピーク飽和出力値	製品データシート中に参照されている出力、飽和出力、最大出力、ピーク出力又はピーク包絡線出力ともいう。	
マイクロ波用ディスクリトランジスタ	貨物等省令第6条第二号ニの(一)から(五)でそれぞれ定める周波数帯域において、2以上の周波数帯域にまたがって作動するものについては、これらのうちピーク飽和出力値の最も低いものを制限値とする。 電力増幅器ともいう。これらは、貨物等省令第6条第二号ニ(一)～(六)の規定に基づいて判定するものとする。	
	被覆されていないダイ、キャリアに搭載されたダイ及びパッケージに搭載されたダイを含む。	

マイクロ波用固体増幅器（モノリシックマイクロ波集積回路増幅器及びハーモニックミキサ又はコンバータを除く。）又はこれを含む組立品若しくはモジュール（送受信モジュール及び送信モジュールを除く。）	貨物等省令第6条第二号ホの（一）から（五）でそれぞれ定める周波数帯域において、2以上の周波数帯域にまたがって作動するものについては、これらのうちピーク飽和出力値の最も低いものを制限値とする。	
貨物等省令第6条第二号ホ中のマイクロ波用固体増幅器	モノリシックマイクロ波集積回路増幅器は貨物等省令第6条第二号ホの規定に基づいて判定し、スペクトラムアナライザ、信号発生器、ネットワークアナライザ又はマイクロ波用試験受信機の動作周波数を拡張するように設計したハーモニックミキサ若しくはコンバータは、貨物等省令第6条第二号リの規定に基づいて判定するものとする。	
組立品	複数の回路素子、個別部品又は集積回路を特定の機能を行うように相互に接続したものであって、一体として交換可能であり、かつ、分解することが可能なものをいう。	
モジュール	基板上に回路素子、個別部品又は集積回路を相互に接続したものであって、一体として交換可能であり、かつ、分解することが不可能なものをいう。	
貨物等省令第6条第二号ホ中のモジュール	送受信モジュール及び送信モジュールは貨物等省令第6条第二号カの規定に基づいて判定するものとする。	
半オクターブ	周波数帯域内の最大周波数と最小周波数の比が、1.5:1のものをいう。	
完全停止状態から完全作動状態までの時間	予熱時間を含む。	
発振器又は発振機能を有する組立品	カタログ等の仕様に従って評価する。	
電子組立品	6の「電子組立品」の解釈に同じ。	

周波数切換えの所要時間	デジタルコード化された電気信号により出力周波数を切換えたときに、出力周波数が1ギガヘルツ未満の場合は終点の±100ヘルツ以内、又は1ギガヘルツ以上の場合は終点の±0.00001パーセント（±0.1ppm）以内に達する時間（例えば遅延時間）をいう。
サイドローブに対するメインローブの電力の比	データシートに示される最大減衰量をいう。
超電導	すべての電気抵抗を消失することができる金属、合金又は化合物が、無限の導電率に達したときジュール熱の発生なしに大電流を流すことが可能なことをいう。
超電導材料を用いた装置	電子素子、回路又はシステムを含む。
臨界温度	5の「臨界温度」の解釈に同じ。
セル	電気化学デバイスであって、正極、負極及び電解質を有し、かつ、電気エネルギー源であるもののうち、バッテリーの基本的な構成部品であるものをいう。
一次セル	外部電源から充電できるように設計されていないものをいう。
貨物等省令第6条第五号中のエネルギー密度	平均出力(W)に放電時間(h)を乗じて得た数値を、セルの質量(kg)で除した数値をいい、公称電圧にアンペア時間で表した公称容量を乗じて得た数値を、キログラムで表した質量で除すことで計算される。公称容量が示されていない場合のエネルギー密度は、公称電圧を二乗して得た数値に、時間で表した放電時間を乗じ、かつ、オームで表した放電負荷とキログラムで表した質量で除して計算することとする。
貨物等省令第6条第五号中の連続的な電力密度	公称電圧にアンペアで表した最大連続放電電流(A)を乗じた電力をキログラムで表した質量で除して計算することとする。 電力密度は比出力ともいう。 最大連続放電電流：カタログに表記されたものを含む最大の連続放電電流をいう。
二次セル	外部電源から充電できるように設計されているものをいう。
高電圧用のコンデンサ	定格電圧が5,000ボルト以上のものをいう。
反復サイクル	所定の電圧において、エネルギーを1秒間に充放電できる回数で、ヘルツで表したものをいう。
最大電流密度	コイルの巻き数に最大電流を乗じた値をコイルの断面積で除した値をいう。
セル連結保護ガラス集成品	インターコネクタ及びカバーガラス付セルを含む。
エア・マス・ゼロ	地球と太陽との間の距離を一天文単位とした場合の地球の大気圏外における太陽光の分光放射照度をいう。

アブソリュートエンコーダ	モーター等の回転角度、回転速度を検出するセンサー（ロータリーエンコーダ）のうち、絶対値を出力する方式のものをいう。	
パルス出力の切換えを行うサイリスターデバイス又はサイリスターモジュール	シリコン制御整流器（SCRs）、エレクトリカルトリガリングサイリスター（ETTs）、光トリガリングサイリスター（LTTs）、集積ゲート整流サイリスター（IGCTs）、ゲートターンオフサイリスター（GTOs）、MOS制御サイリスター（MCTs）及びソリッドトロン（Solidtrons）を含む。	
サイリスターモジュール	1以上のサイリスターデバイスで構成されるものをいう。	
貨物等省令第6条第八号の三中の半導体素子	接合電界効果トランジスタ（JFETs）、垂直接合電界効果トランジスタ（VJFETs）、MOS電界効果トランジスタ（MOSFETs）、二重拡散金属酸化物半導体電界効果トランジスタ（DMOSFETs）、絶縁ゲートバイポーラトランジスタ（IGBT）、高電子移動度トランジスタ（HEMTs）、バイポーラ接合トランジスタ（BJTs）、サイリスター及びシリコン制御整流器（SCRs）、ゲートターンオフサイリスター（GTOs）、エミッターターンオフサイリスター（ETOs）、PINダイオード、ショットキーダイオードを含む。	
貨物等省令第6条第八号の三中の半導体モジュール	1以上の電力の制御又は電気信号の整流を行う半導体素子で構成されるものをいう。	
繰返しピーク休止状態電圧	ドレイン・ソース電圧、コレクター・エミッター電圧、繰返しピーク逆電圧、ピーク繰返し休止状態ブロック電圧を含む。	
半波長電圧	光変調器を伝搬する光の波長において180度の位相変化を作るのに必要な印加電圧をいう。	
サンプリングオシロスコープ		等価時間サンプリング方式を用いたものを除く。
貨物等省令第6条第十号中のアナログデジタル	アナログデジタル変換器のうち、アナログデジタル変換を行う機能を有するモジュール、電子組立品又は装置については、以下のとおりとする。 イ nビットの分解能とは、 2^n レベルに相当する量子化能力をい	

<p>ル変換器のうち、アナログデジタル変換を行う機能を有するモジュール、電子組立品又は装置</p>	<p>う。</p> <p>ロ ADCの分解能は、測定したアナログ入力を表すADCのデジタル出力ビット数に等しい。有効ビット数(ENOB)はADCの分解能を決定するに当たり、使用しない。</p> <p>ハ インターリーブ型でない複数のチャンネルを有するモジュール、電子組立品又は装置については、そのサンプルレートは複数のチャンネルを集合させたものではなく、1つのチャンネルのうち最大のものをいう。</p> <p>ニ インターリーブ型のチャンネルを有する複数のチャンネルを有するモジュール、電子組立品又は装置のサンプルレートは、インターリーブに係る全てのチャンネルのサンプルレートを集合させた最大のレートをいう。</p> <p>(判定方法) 複数のチャンネルを有するものは、一つのチャンネルで実現できる最も性能の高いチャンネルで判定する。</p> <p>(判定条項の参照先) サンプリングオシロスコープ、デジタル方式の記録装置、スペクトラムアナライザ、信号発生器、ネットワークアナライザ及びマイクロ波用試験受信機は、それぞれ貨物等省令第6条第九号、第十一号から第十五号までの規定に基づいて判定するものとする。</p>
<p>貨物等省令第6条第十一号イ中のデータ連続記録速度</p>	<p>デジタル方式の記録装置が、デジタルデータのサンプルレート又はデジタル信号への変換速度を維持した状態で、デジタル信号の情報を欠落なく連続してディスクメモリ又はソリッドステートドライブメモリに出力することができる速度をいい、パラレルアーキテクチャを有する記録装置については、最大ワード転送速度にワードを構成するビット数を乗じたものをいう。</p>
<p>周波数シンセサイザ</p>	<p>出力周波数の数より少ない数の基準周波数により制御、導出又は統合し、一つ若しくは多数の出力周波数を同時若しくは選択的に出すことができる周波数源をいう。</p>
<p>送受信モジュール</p>	<p>信号の送受信のために双方向の振幅及び位相制御を行うことができる多機能電子組立品をいう。</p>
<p>送信用モノリシックマイクロ波集積回路</p>	<p>信号の送受信のために双方向の振幅及び位相制御を行うことができる多機能モノリシックマイクロ波集積回路をいう。</p>
<p>送信モジュール</p>	<p>信号の送信のために振幅及び位相制御を行うことができる電子組立品をいう。</p>
<p>送受信モジュール又は送信モジュール</p>	<p>貨物等省令第6条第二号カの規定は、放熱板の有無にかかわらず送受信モジュール又は送信モジュールを規制する。また、貨物等省令第6条第二号カ(三)における平面のいずれかの辺の長さには、送受信モジュール又は送信モジュールの放熱板として機能する部分を含まない。</p>
<p>送信用モノリシックマイクロ波集積回路</p>	<p>信号の送信のために振幅及び位相制御を行うことができる送信用モノリシックマイクロ波集積回路をいう。</p>
<p>送受信モジュール、送信用モノリシックマイクロ波集積回路、送</p>	<p>送信又は送受信チャンネルと同数の集積化された放射アンテナ素子を持つ場合も持たない場合もある。</p>

信モジュール又は送信用モノリシックマイクロ波集積回路	
貨物等省令第6条第二号カ(三)中の計算式	<p>動作帯域幅の下限が2.7ギガ以下に及ぶ場合、最小動作周波数として2.7ギガヘルツを用いるものとする。</p> <p>次の式を満たすものとする。</p> $d [\text{cm}] \leq 15 \times N / f [\text{GHz}]$ <p>d : 平面のいずれかの辺の長さをセンチメートル (cm) で表した値 N : 一つの辺に並べられた送信又は送受信のチャンネル数 f : ギガヘルツ (GHz) で表した最小動作周波数</p>
貨物等省令第6条第二号カ中のチャンネル	平面に並べられた複数の送受信モジュール、送信用モノリシックマイクロ波集積回路、送信モジュール又は送信用モノリシックマイクロ波集積回路の任意の固体をいう。
信号発生器	<p>任意波形発生器及びファンクションジェネレーターを含む。任意波形発生器又はファンクションジェネレーターの最大出力周波数は、次のいずれかに従って評価する。</p> <p>イ カatalog等に最大出力周波数が表記されている場合は当該仕様</p> <p>ロ カatalog等に最大出力周波数が表記されていない場合はサンプル毎秒で表したサンプルレートを2.5で除して算出されるもの</p>
貨物等省令第6条第十三号イ(一)中のパルス幅	立ち上がりエッジにおける振幅の50パーセントの時点から立ち下りエッジにおける振幅の50パーセントの時点までの時間間隔をいう。
スペクトラムアナライザー	多周波数信号の中から単一周波数成分の基本的な特性を測定し、かつ、表示することができる装置をいう。
貨物等省令第6条第十二号ニに該当するスペクトラムアナライザー	定比幅フィルター (オクターブフィルター又は分数オクターブフィルターともいう。)のみを用いたものを除く。
実時間帯域幅	周波数分析器が変換後のデータを外部に出力又は表示しながら、ギャップ又は窓効果による実振幅からの減衰が3デシベルを超えずに全ての入力信号を処理するフーリエ変換又は他の離散時間変換により、タイムドメインデータの全てを周波数ドメインに連続的に変換することができる最大周波数範囲をいう。
貨物等省令第6条第十二号ニ中の100パーセントの確率で検出する	100パーセントの確率で検出するための時間は、仕様にあるレベルの測定の不確かさに必要な最小信号持続時間に相当する。

周波数マスクトリガー	設定した周波数帯域幅内でトリガーする周波数帯域の範囲を選択することができ、その範囲以外の信号が当該周波数帯域幅内に存在しても無視する機能をいう。	
	1つ以上の独立したリミットを含む。	
ベクトル変調帯域幅	無線周波数信号がデジタルベースバンド信号により変調された際の、無線周波数信号の帯域幅をいい、情報帯域幅ともいう。I/Q変調を用いたデジタル変調は無線周波数ベクトル変調信号を生成するための技術的な手法であり、その出力信号は一般的にベクトル変調帯域幅を有するものとして仕様化されている。	
非線形ベクトルの計測機能	計測対象の装置を大信号ドメイン又は非線形歪みの領域に追い込んで試験し、その結果を解析することができるネットワークアナライザの機能をいう。	
半導体素子	イメージデバイス、光電子素子及び弾性波素子を含む。	
半導体物質	<p>純度99.9パーセント以上のものであって、次のいずれかに該当するものをいう。</p> <p>イ シリコン又はゲルマニウムの多結晶のもの又は単結晶のもの</p> <p>ロ III族元素であるアルミニウム、ガリウム又はインジウムとV族元素である燐、砒素又はアンチモンとの化合物の結晶（ガリウム・砒素などの二元系化合物半導体結晶に加えインジウム・ガリウム・砒素・燐などの多元系化合物半導体結晶を含む。）</p> <p>ハ II族元素である亜鉛、カドミウム又は水銀とVI族元素である硫黄、セレン又はテルルとの化合物の結晶（硫化カドミウムなどの二元系化合物半導体結晶に加え、テルル化水銀カドミウムなどの多元系化合物半導体結晶を含む。）</p> <p>ニ 半導体素子用のシリコンカーバイドの単結晶</p> <p>ホ シリコンとゲルマニウムとの混合物の単結晶</p> <p>ヘ その他、半導体としての物性を備え、半導体素子に用いられるもの</p>	
部分品 附属品		他の用途に用いることができるものを除く。
貨物等省令第6条第十七号イ(一)中のシリコン以外の膜を形成できるもの	原子層エピタキシー法を用いた装置を含む。	
有機金属化学的気相成長反応炉	装置を含む。	
ウエハー搬送中央装置		複数のウエハーに対し同一処理を同時に行うように設計したもの（ロボットを用いたものも含む。）を除く。

<p>貨物等省令第6条第十七号ホ中の半導体製造装置であってそれぞれ異なるもの</p>	<p>半導体製造装置であって、機能的に異なる物理的処理（デポジション、イオン注入又は熱処理を含む。）を行うモジュール式装置をいう。</p>	
<p>貨物等省令第6条第十七号ホ中の複数のウエハー処理を順次行う</p>	<p>マルチチャンバー対応ウエハー搬送中央装置により、同一のウエハーを第一の処理を行う装置から第二の処理を行う装置へ、第二の処理を行う装置から第三の処理を行う装置へ搬送することなどにより、同一のウエハーを異なる半導体製造装置で処理することをいう。</p>	
<p>インプリントリソグラフィ装置</p>	<p>マイクロコンタクトプリンティング装置、ホットエンボシング装置、ナノインプリントリソグラフィ装置及びステップアンドフラッシュインプリントリソグラフィ装置を含む。</p>	
<p>貨物等省令第6条第十七号ヲ(二)中の同一装置による重ね合わせ精度</p>	<p>ウエハーの既存のパターン上に、新しいパターンを形成する際に、両方のパターンを同一の装置で形成する場合の重ね合わせ精度をいう。</p>	
<p>貨物等省令第6条第十七号カ中のドライエッチング</p>	<p>ラジカル（開殻電子配置にある不対電子を有する原子、分子又はイオンをいう。）、イオン、逐次的な反応又は逐次的でない反応によるエッチングを含む。</p>	
<p>貨物等省令第6条第十七号カ(一)中のシリコンゲルマニウムのシリコンに対するエッチング選択性の比率</p>	<p>ゲルマニウム濃度が30パーセント以上のシリコンゲルマニウムを用いて測定するものとする。</p>	
<p>貨物等省令第6条第十七号カ(二)中の異方性ドライエッチング</p>	<p>高周波パルス励起プラズマ、パルスデューティサイクル励起プラズマ、パルス電圧印可電極調整プラズマ若しくはプラズマと組み合わせた周期的ガス注入及びパージによるエッチング、プラズマ原子層エッチング又はプラズマ準原子層エッチングを含む。</p>	

貨物等省令第6条第十七号タ、レ(十)、ラ又はオ中の幅	最表面における幅をいう。	
貨物等省令第6条第十七号レ(一)中の成膜するように設計したもの	半導体ウェハの処理を行う装置に限る。	
貨物等省令第6条第十七号レ(九)中の原子層堆積装置	下地の導電体との界面にバリア膜を用いずに充填金属を形成させることを可能とするバリア膜を選択的に成膜することができるものを含む。	
貨物等省令第6条第十七号ラ中の成膜装置	シリコン及び炭素を含有し、かつ、ゲート電極の側壁を覆う膜を成膜するために設計したものに限る。	
貨物等省令第6条第十七号ヤ中の洗浄除去装置		成膜装置を除く。
貨物等省令第6条第十七号マ中の複数のチャンバー又はステーションを有する洗浄除去装置	表面の酸化物を除去する前処理又は表面の汚染物の除去を行うチャンバー又はステーションが、他の処理を行うチャンバー又はステーションと独立しているもの(他の処理を行うチャンバー又はステーションが存在しないものを含む。)に限る。	
		次のいずれかに該当するものを除く。 イ 不活性ガスを用いた物理的な手法によるもの ロ レジストを除去するために設計したもの ハ 成膜装置
貨物等省令第6条第十七号ケ中の表面改質	表面のシリル化をいう。	
貨物等省令第6条第十七号フ中の検査するように設計した装置	マスクブランク又はマスクの欠陥(パーティクルを含む。)の有無を検査するものに限る。	

貨物等省令第6条第十七号の二中のペリクル	フレームと一体化された膜であって、パーティクルによる汚染からマスク又はレチクルを保護するように設計したものをいう。	
マスクブランク	マスクの製造に用いられるガラスの板その他の材料に薄膜を形成したものをいい、これにレジストが塗布されているかどうかを問わない。	
貨物等省令第6条第十七号の四中の走査型電子顕微鏡	チップの設計の復元用に設計したものを含む。	
極端紫外	電磁波スペクトルの波長が5ナノメートルを超え、124ナノメートル未満のものをいう。	
多層膜の結晶を有し、かつ、当該結晶がエピタキシャル成長されているものうち、ヘテロエピタキシャル材料となるもの	異種の半導体物質が同一結晶方位に結晶構造を連続させて積層成長してできた多層の結晶成長層を有する基板をいう。	
	多層膜からなるヘテロエピタキシャル成長結晶を有する基板からなる材料を含む。	
貨物等省令第6条第十八号、第十九号及び第二十二号から第二十四号までの基板	個別部品又は集積回路を、基板上若しくはその中に配置できるようになっている薄板状のものであって、相互接続の有無によらないものをいう。	
Ⅲ－Ⅴ族化合物	ほう素、アルミニウム、ガリウム、インジウム、タリウム又はこれらの組合せと窒素、燐、砒素、アンチモン、ビスマス又はこれらの組合せとの化合物をいう。	
窒化ガリウム、窒化インジウムガリウム、窒化アルミニウムガリウム、窒化インジウムアルミニウム、窒化インジウムアルミニウムガリウム、リン化ガリウム、砒化ガリウム、砒化アルミ	これらの化合物における元素（窒素、ガリウム、インジウム、アルミニウム、 ^{りん} 燐及び砒素）の順番を問わない。	

ニウムガリウム、リン化インジウム、リン化インジウムガリウム、リン化アルミニウムインジウム又はリン化インジウムガリウムアルミニウム		
レジスト	半導体製造用のレジスト(ソルダーレジストを除く。)であって、レジスト材である樹脂(ベースポリマー)を含む。	
ポジ型レジスト	照射された部分のみが現像液に溶解するレジストをいう。	
貨物等省令第6条第二十号中の有機金属化合物又は有機化合物	アルミニウム、ガリウム、インジウム、 ^{りん} 、 ^ひ 燐、砒素又はアンチモンが、分子の有機部分の炭素と直接に結合している化合物をいう。	
純度	アルミニウム、ガリウム、インジウム、 ^{りん} 、 ^ひ 燐、砒素又はアンチモン成分の純度をいう。	
不活性ガス	ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン又は窒素をいう。	
貨物等省令第6条に掲げる貨物		次のいずれかに該当するものを除く。 イ 医療用に設計された装置 ロ 医療用に設計された装置に組み込まれたもの